

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0593U000027

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-02-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Романюк Борис Николаевич

2. Романюк Борис Николаевич

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd\_type\_names.0

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 25-12-1992

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: 252022,Київ-22, пр. Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 016.25.01

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут напівпровідників АН України

**Код за ЄДРПОУ:** 05416952

**Місцезнаходження:** 252650, Київ-28, пр.Науки, 45

**Форма власності:**

**Сфера управління:** НАН України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 29.19.31

**Тема дисертації:**

1. Процессы ионно-стимулированного массопереноса и гетерирования в полупроводниковых планарных структурах

2.

**Реферат:**

1. Объект исследования: Полупроводниковые кристаллы кремния и слоистые структуры диэлектрик-полупроводник. Цель исследования: Разработка научных основ ионно-стимулированного формирования слоистых структур и изучение процессов переноса и взаимодействия точечных дефектов с атомами примесей в кремнии. Методы исследования и аппаратура: Просвечивающая и растровая электронная микроскопия, рентгеновская спектроскопия, комбинационное рассеивание и электроотражение света, резерфордское рассеивание альфа-частиц; электронные микроскопы, установки для имплантации, оптические приборы, Оже-спектрометр. Теоретические результаты и новизна: Установление механизмов ионно-стимулированного упорядочивания; кристаллические решетки; изучение механизма стимулированного гетерирования; выявление эффектов лазерно-стимулированной диффузии кислорода и каталитической роли угля. Практические результаты и новизна: Разработана и внедрена в производство технология гетерирования при эпитаксиальном росте пленок. Предложены методы создания скрытых

диелектрических слоев и p-n переходов при низких температурах. Получено 10 авторских свидетельств на изобретение. Предмет и степень внедрения: Технология гетерирования примесей в эпитаксиальных пленках внедрена на ВО "Гама" г.Запорожье. Эффективность внедрения: Экономический эффект от внедрения результатов 3 млн.крб. Сфера (область) использования: Микроэлектроника, технология полупроводниковых материалов.

2.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Птушинский Ю.Г.

2. Птушинский Ю.Г.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.04, 1

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Баранский П.И.
2. Баранский П.И.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.10, 1

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мордкович В.Н.
2. Мордкович В.Н.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.10, 1

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

**VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Свечников С.В.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Свечников С.В.

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.